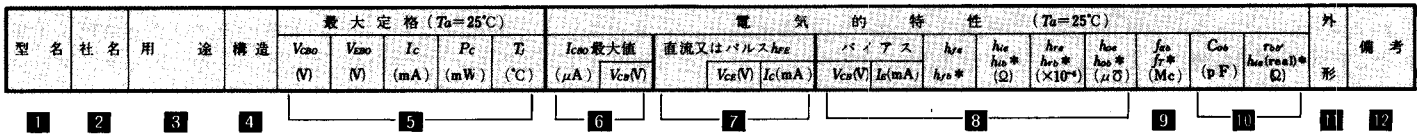
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μΩ)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD 11	日電	SW	Ge. A	25	15	300	150	85	10	25	70	1	20	6	−1					2.5			84 A	
★	〃 12	松下	PA	Si. Me	75	4	2.5A	60 W (T_c=25°C)	150	10mA	75	50	4	1 A										103	
★	〃 13	〃	〃	〃	35	4	10 A	100 W (T_c=25°C)	150	40mA	35	40	10	2.5A										109	
★	〃 14	〃	〃	〃	75	4	10 A	100 W (T_c=25°C)	150	45mA	75	30	4	10 A										109	
	〃 15	サンケン	PA. SW	Si. DJ	60	6	6 A	80 W (T_c=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
	〃 16	〃	〃	〃	100	6	6 A	80 W (T_c=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
	〃 17	〃	〃	〃	150	6	6 A	80 W (T_c=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
	〃 18	〃	PA	〃	200	6	6 A	80 W (T_c=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
★	〃 19	日電	〃	Ge. A	25	10	300	150	85	12	12	31	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB219 とコンプリ
★	〃 20	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	50	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB220 とコンプリ
★	〃 21	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	72	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB221 とコンプリ
★	〃 22	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	97	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB222 とコンプリ
★	〃 23	〃	〃	〃	25	10	300	150	85	12	12	150	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB223 とコンプリ
★	〃 24	三洋	〃	Si. Me	300	2	100	6 W (T_c=70°C)	110	1.5	100	60	10	50	30	−20					25*	17		99	
★	〃 25	日電	〃	Ge. A	25	10	100	110	75	14	12	70	1	50	6	−1					1			12 A	
★	〃 26	三菱	PA. SW	Si. EP	40	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}≒120 (4 V, 1 A)							103	
★	〃 26A	〃	〃	〃	60	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}≒120 (4 V, 1 A)							103	
★	〃 26B	〃	〃	〃	100	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}≒120 (4 V, 1 A)							103	
★	〃 26C	〃	〃	〃	150	5	7 A	50 W (T_c=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}≒120 (4 V, 1 A)							103	
★	〃 27	松下	PA	Ge. A	32	10	500	280	90	10	0.5	95	0.5	300										12 A	
★	〃 28	ソニー	〃	Si. DJ	70		3 A	18 W (T_c=25°C)	150	20	30	100	1	100										100	
★	〃 29	〃	〃	〃	70		3 A	18 W (T_c=25°C)	150	20	30	100	1	100										100	
★	〃 30	三洋	〃	Ge. A	25	12	200	300	85	15	20	100	1.5	100	6	−1					1			63	2SB22 とコンプリ
★	〃 31	松下	〃	〃	25	10	125	125	75	15	10	50	1	100				NF≒3 dB						12 B	2SB172 とコンプリ
★	〃 32	〃	〃	〃	25	10	125	125	75	15	10	90	1	100				NF≒3 dB						12 B	2SB176 とコンプリ
★	〃 33	富士通	〃	〃	20	2.5	50	150	85	14	12	70	1	50	6	−1	60	1780	3.8	17.3	2			12 A	2SB33 とコンプリ
★	〃 34	〃	〃	〃	20	2.5	150	250	85	14	12	100	1	150	6	−1	60	1800	5	20	2			71 A	2SB34 とコンプリ
★	〃 35	松下	〃	〃	20	10	60	83	75	10	10	72	1	18										4	
★	〃 36	〃	〃	〃	20	10	60	83	75	10	10	150	1	37.5										4	
★	〃 37	富士通	〃	〃	30	12	50	150	85	14	30	7	1	50	6	−1	60	1780	3.8	17.3	2			12 A	2SB37 とコンプリ